**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podstawek krzemowych (wafers) wymienionych

poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

* Si-wafers 4” 60 szt.
* Si-wafers 2” 20 szt.
* Si-wafers 4” 20 szt.
1. **Zakres przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu.

1. **Kryteria**

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Maksymalna ilość punktów S | Metoda przyznawania punktów |
| Cena netto (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

* Pi – cena netto towarów wraz z dostawą - dla danej przedłożonej oferty
* Pmin - minimalna cena netto dostawy zamawianych towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert
* S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. (zaokrąglając od „5” w górę)

1. **Termin wykonania zamówienia: Najszybciej jak to możliwe nie później niż 9 tygodni od dnia złożenia zamówienia**

**5.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr  | Specyfikacja |
| **Si-Wafer 4”** | Średnica 4” Średnica: 100 ±0.3 mmGrubość: 400 ±20 μm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
| Metoda wzrostu | FZ |
| Domieszka | nie domieszkowane |
| Orientacja | <100> ±0.5° |
| Rezystancja.: | >10,000 Ohm-cm |
| TTV | <10 μm |
| Wykończenie powierzchni | Dwustronnie polerowana |
| Pakowanie: | kaseta |
| **Si-Wafer 2”** | Średnica 2” Średnica: 50.8 ±0.3 mmGrubość:279 ±15 μm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
| Metoda wzrostu | CZ |
| Domieszkowanie | nie domieszkowane |
| Orientacja: | <100> ±1° |
| Typ przewodnictwa | P/B |
| Rezystywność | 1-5 Ohm-cm |
| TTV | <10 μm |
| Wykończenie powierzchni | Dwustronnie polerowane |
| Pakowanie: | Standardowe kasety, szczelnie zamknięte |
| **Si-Wafer 4”** | Średnica 4” Średnica: 100 ±0.2 mmGrubość:525 ±15 μm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
| Metoda wzrostu | CZ |
| Domieszkowanie | nie domieszkowane |
| Orientacja: | <100> ±0.5° |
| Typ przewodnictwa | P/B |
| Rezystywność | 0.01-0.02 Ohm-cm |
| TTV | <5 μm |
| Wykończenie powierzchni | Dwustronnie polerowane |
| Pakowanie: | Standardowe kasety, szczelnie zamknięte |